Лекция 7 Физические основы

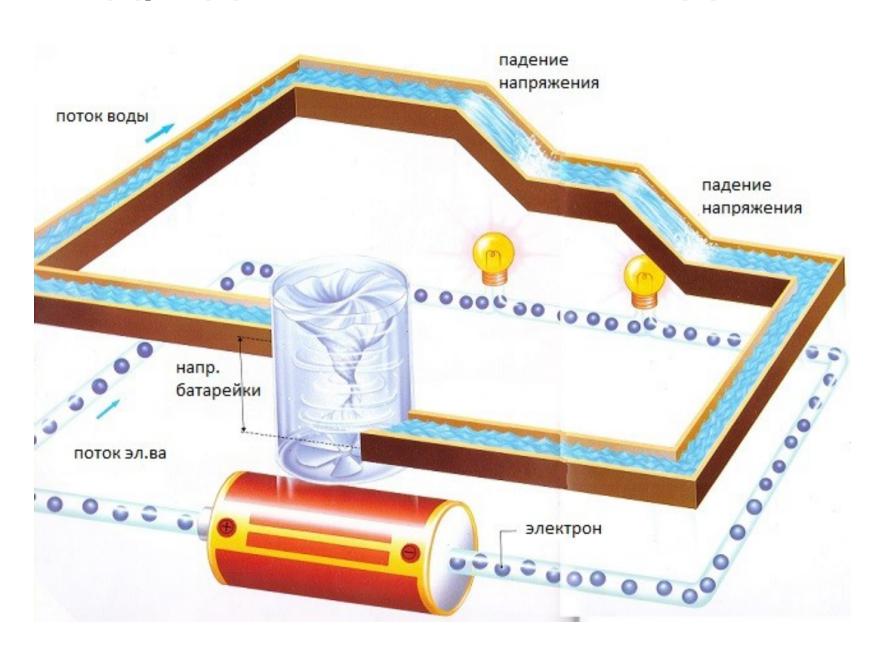
Физические основы

- Электрический заряд свойство тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии
 - Закон Кулона, закон Ампера, ...
- Заряд квантуется, е элементарный электрический заряд, заряд электрона -е

Электрический ток

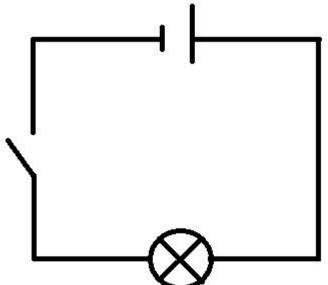
- Электрический ток
 - Протекание заряда через некоторое сечение за единицу времени
 - I = dq/dt
 - Единица измерения ампер
- Напряжение (разность потенциалов)
 - ΔV или ΔU работа эффективного электрического поля по перемещению пробного заряда между двумя точками цепи
 - Единица измерения вольт

Гидродинамическая модель



Электрическая цепь

- Совокупность элементов, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью силы тока I и напряжения V
- В электрической цепи есть условный 0 (земля)

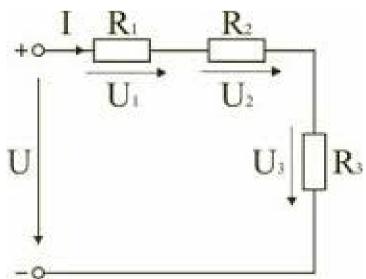


Электрическая цепь

- Ток течет в направлении уменьшения потенциала (от + к -)
- Основные носители заряда (электроны) движутся в обратном направлении
- Линейная цепь поведение описывается линейными дифференциальными уравнениями

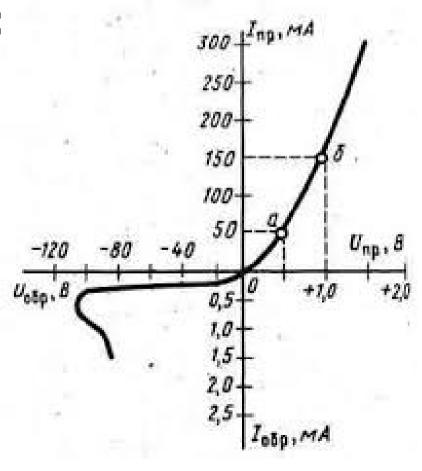
Цепь постоянного тока

- В каждой точке цепи ток не меняется со временем
- Закон Ома: I = V/R
- R (активное) сопротивление участка цепи характеристика преобразования электрической энергии в тепловую
- $P = I*V = V^2 / R$



Вольт-амперная характеристика

- Зависимость протекающего тока от приложенного напряжения
- Резистор линейная ВАХ



Цепь переменного тока

- Напряжение изменяется по закону:
 V = V₀ sin φ
- Линейные элементы резисторы, конденсаторы, индуктивности
- Закон ома:
 I = V / R
- I, V, R комплексные числа
- Сопротивление R состоит из двух компонент: активной и реактивной

Цепь переменного тока

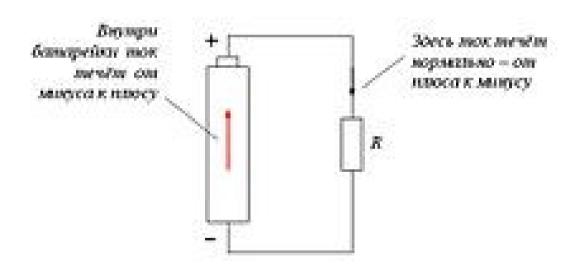
- Емкость С свойство элемента цепи накапливать заряд
- Элемент цепи конденсатор
- Реактивное сопротивление: 1/ωС
- Индуктивность L свойство элемента цепи порождать магнитное поле
- Элемент цепи катушка индуктивности
- Реактивное сопротивление: ωL

Цифровая электроника

- Напряжение передает сигнал
 - 5V TTL Logic:
 - 0 0.8V "Low" (logical 0)
 - 2.0 5.0 "High" (logical 1)
- Логические элементы должны обладать
 - Малым "выходным" сопротивлением (чтобы падение напряжения не искажало сигнал)
 - Большим "входным" сопротивлением (чтобы тек маленький ток)
- Выходы могут переключаться в режим "высокоимпедансного состояния" как бы отключаются от цепи
- Ток течет при переключении состояния

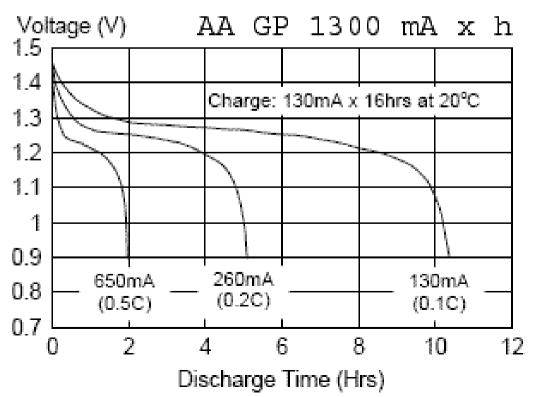
Электропитание

- Электрическая сеть
- Топливные элементы
- Аккумуляторы



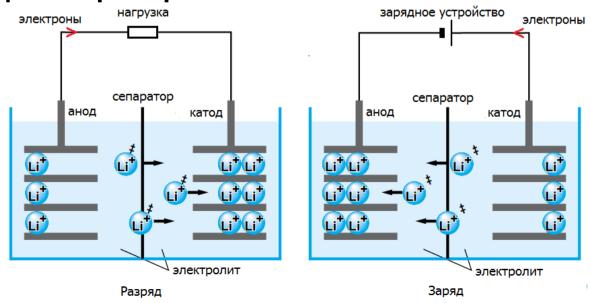
Емкость аккумуляторов

- Измеряется в ампер-часах или ма*ч
- Например, 2000 mAh означает, что аккумулятор способен выдать ток 2A в течении одного часа
- На самом деле: нелинейная зависимость от нагрузки



Li-ion аккумуляторы

- Батареи состоят из нескольких ячеек
- Телефоны и другая мобильная электроника
 одна ячейка
- Потенциал заряженной ячейки 4.3V
- Потенциал разряженной ячейки 2.5 3V



Материалы

- Анод (+) графит
- Катод (-) металл, нестабильный при высоком заряде (высокая степень окисления)
- Электролит органический растворитель с ионами Li
- Все материалы горючи

Безопасность

- При перегреве разлагается электролит, "вспухание"
- При перезаряде крайне неустойчивый катод – тепловой разгон
- При переразряде распад электролита
- При КЗ тепловой разгон
- Крайне важно поддерживать правильный режим зарядки и разрядки аккумулятора

Управляющий контроллер

- Каждый аккумулятор содержит управляющий программируемый микроконтроллер (~32 KiB Program ROM, ~4KiB RAM, ~4KiB Flash ROM)
- Ошибка в программе микроконтроллера может приводить к критическим последствиям

Прогресс в технологиях

- 20 лет назад емкость катода 100-120 мАч/г
- сейчас используется катод с 160-180 мАч/г

lacktriangle

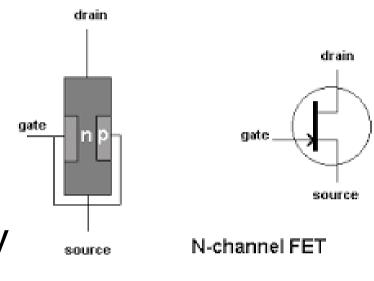
• За 20 лет "плотность" аккумулирования энергии увеличилась на 60%

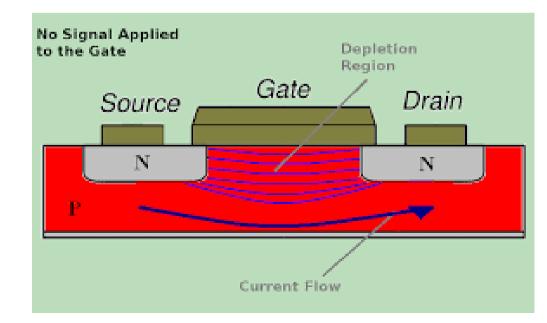
Транзистор

- Первый транзистор 1947 (Бардин, Бреттейн, Шокли)
- Нобелевская премия по физике 1956 г
- Одно из важнейших изобретений 20 века
- Типы транзисторов:
 - Биполярный (bipolar junction transistor BJT)
 - Полевой (Field-effect transistor FET)

Полевой транзистор

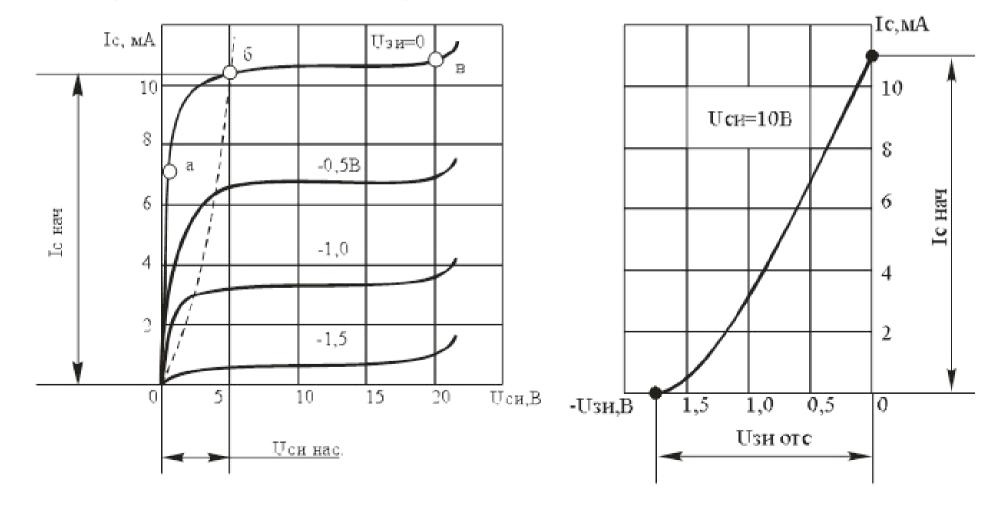
- Затвор «кран»
- Исток -> Сток
- N электроны перемещаются навстречу току
- Затвор изолирован (ток не течет через затвор)





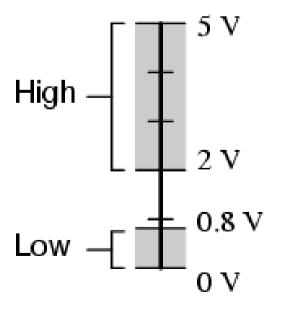
Полевой транзистор

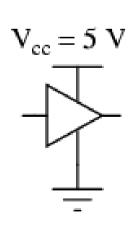
• Слева — ВАХ исток-сток при фикс. напряжении затвор-исток



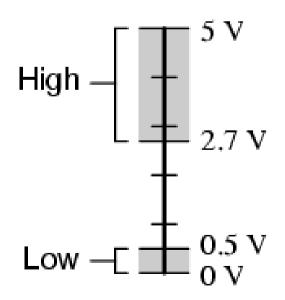
Передача сигнала

- В цифровой электронике сигнал передается изменением напряжения. Два уровня напряжения: V0 и V1.
- Acceptable TTL gate input signal levels



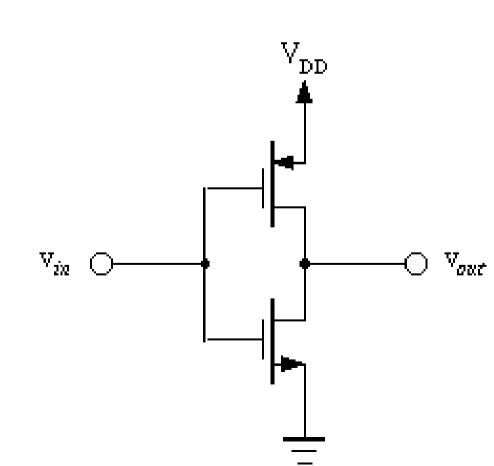


Acceptable TTL gate output signal levels



Цифровая схема

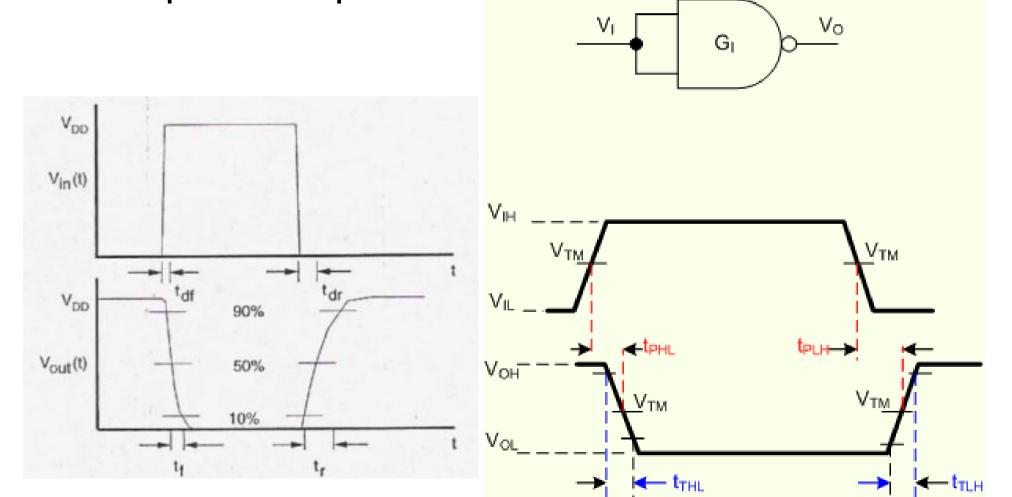
- Шина питания (Vcc) (5V, 3.3V, ...)
- Земля (GND, 0V)
- Входы
- Выходы
- Пример инвертор



Задержка распространения (propagation delay)

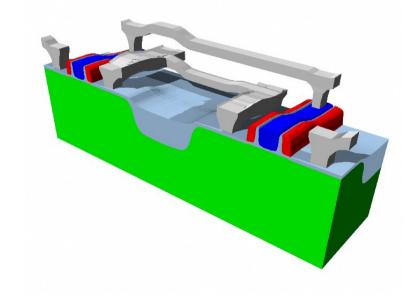
• Скорость передачи ЭМ сигнала в носителе

• Скорость переключения транзисторов



Характеристики инвертера

- Tf время падения напряжения на выходе от «1» до «0»:
 - Tf ~ k1*C/V
- Рассеиваемая мощность:
 - $W \sim k2*C*V^2*f$



Подключение компонентов

- Point-to-point: RJ45 Ethernet, RS232, SPI
 - RX, TX разведены
 - Асинхронные
 - Гальванически развязываются
 - Гибкий протокол
- Ho!
 - +1 провод на устр
 - последовательный

Figure 1: Two SPI busses topologies. The upper figure shows a SPI master connected to a single slave (point-to-point topology). The lower figure shows a SPI master connected to multiple slaves.

